

トランジスタ

2SB709, 2SB709A

# 2SB709, 2SB709A

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形 / Si PNP Epitaxial Planar

一般増幅用 / General Amplifier

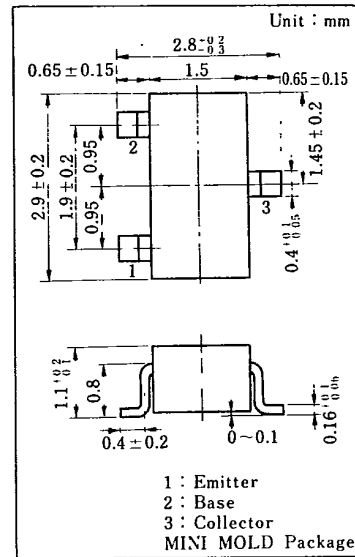
2SD601, 2SD601A とコンプリメンタリ / Complementary Pair with 2SD601, 2SD601A

■ 特徴 / Feature

- 直流電流増幅率  $h_{FE}$  が高い。 / High  $h_{FE}$

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ( $T_a = 25^\circ C$ )

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CBO}$	25	V
	2SB709A	45	
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	25	V
	2SB709A	45	
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	5	V
せん頭コレクタ電流	$-I_{CP}$	200	mA
コレクタ電流	$-I_C$	100	mA
コレクタ損失	$P_C$	200	mW
接合部温度	$T_J$	125	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +125	$^\circ C$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ( $T_a = 25^\circ C$ )

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	$-I_{CBO}$	$-V_{CB} = 10 V, I_E = 0$			1	$\mu A$
	$-I_{CEO}$	$-V_{CE} = 10 V, I_B = 0$			100	
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CBO}$	$-I_C = 10 \mu A, I_E = 0$	25			V
	2SB709A		45			
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	$-I_C = 2 mA, I_B = 0$	25			V
	2SB709A		45			
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	$-I_E = 10 \mu A, I_C = 0$	5			V
直流電流増幅率	$h_{FE}^*$	$-V_{CE} = 10 V, -I_C = 2 mA$	160		460	
トランジション周波数	$f_T$	$-V_{CB} = 10 V, I_E = 1 mA$		80		MHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$-V_{CE(sat)}$	$-I_C = 100 mA, -I_B = 10 mA$		0.3	0.5	V
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$-V_{CB} = 10 V, I_E = 0, f = 1 MHz$		2.7		pF

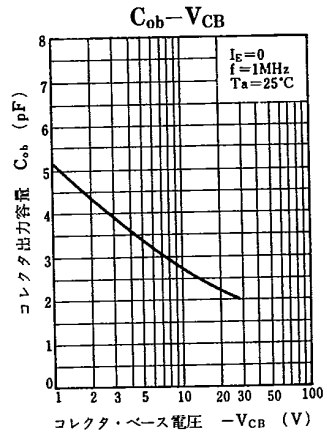
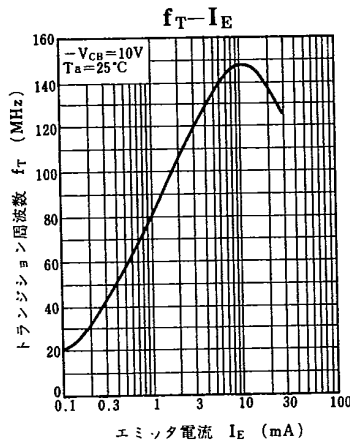
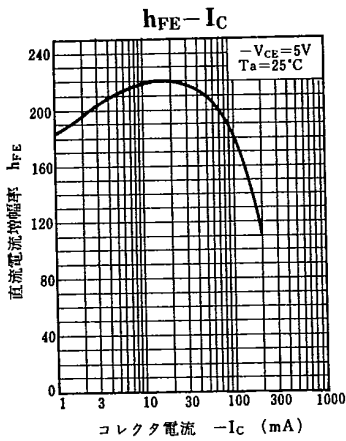
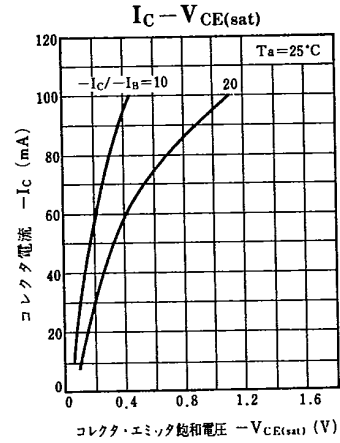
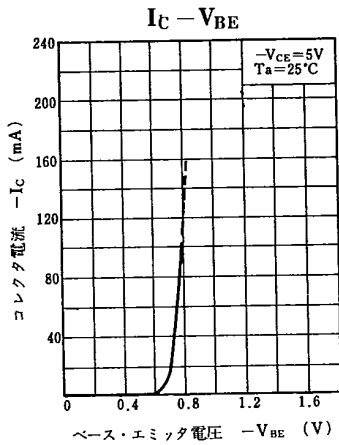
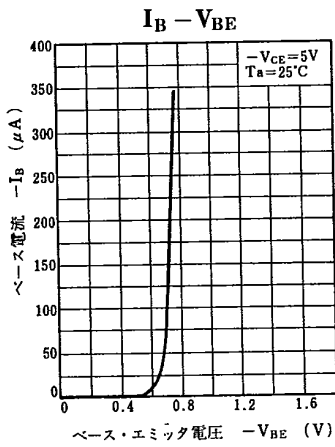
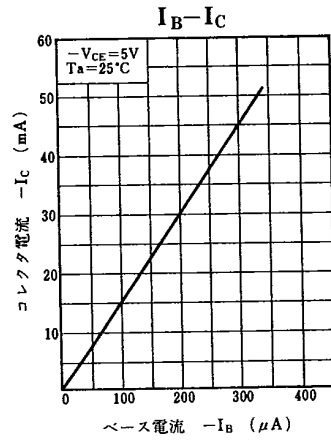
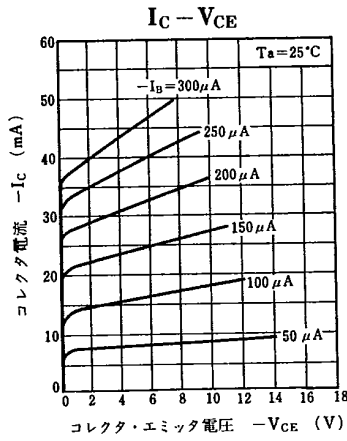
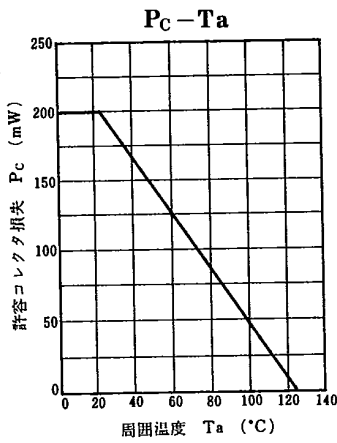
\*  $h_{FE}$  ランク分類 /  $h_{FE}$  Classifications

Class	Q	R	S
$h_{FE}$	160 ~ 260	210 ~ 340	290 ~ 460
Marking Symbol	2SB709 AQ	AR	AS
	2SB709A BQ	BR	BS

トランジスタ

T-29-15

2SB709, 2SB709A



トランジスタ

T-29-15

2SB709, 2SB709A

